

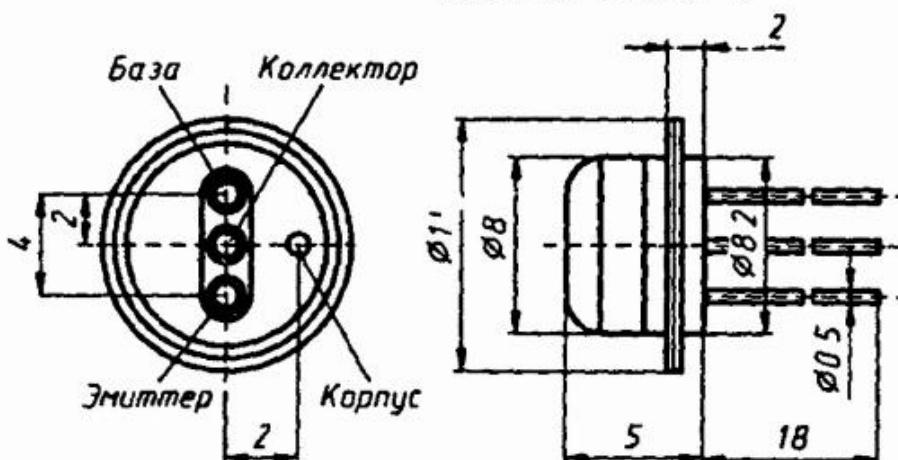
1T311А, 1T311Б, 1T311Г, 1T311Д, 1T311К, 1T311Л, ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И

Транзисторы германиевые планарные структуры *p-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой частот и переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов,
г. Киев.

T311(А-Л) ГТ311(Е-И)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 3$ В, $I_c = 15$ мА:

$T = +25$ °C:

1T311А	15...180
1T311Б	30...180
1T311Г	30...80
1T311Д, 1T311К	60...180
1T311Л	150...300
ГТ311Е	15...80
ГТ311Ж	50...200
ГТ311И	100...500

типовье значения:

1T311А	72*
1T311Б	79*
1T311Г	58*
1T311Д	112*
1T311К	114*
1T311Л	223*

$T = -60^{\circ}\text{C}$:	
1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D, 1T311K, 1T311L, не менее	10 и 0,35 зна- чения при $T = +25^{\circ}\text{C}$
$T = -40^{\circ}\text{C}$:	
ГТ311Е	10...80
ГТ311Ж	25...200
ГТ311И	50...300
$T = +55^{\circ}\text{C}$:	
ГТ311Е	15...150
ГТ311Ж	50...350
ГТ311И	100...500
$T = +70^{\circ}\text{C}$, не более:	
1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D, 1T311K	300 и 3 значе- ния при $T = +25^{\circ}\text{C}$
1T311L	500 и 3 значе- ния при $T = +25^{\circ}\text{C}$

Граничная частота коэффициента передачи

тока при $U_{\text{кз}} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 5 \text{ мА}$:

1T311A, 1T311B	300...1000 МГц
1T311G, 1T311K	450...1500 МГц
1T311D, 1T311L	600...1500 МГц
ГТ311Е, не менее	250 МГц
ГТ311Ж, не менее	300 МГц
ГТ311И, не менее	450 МГц
типовье значения:	
1T311A	770* МГц
1T311B	520* МГц
1T311G	560* МГц
1T311D, 1T311K	830* МГц
1T311L	870* МГц

Постоянная времени цепи обратной связи

при $U_{\text{кз}} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 5 \text{ мА}$, $f = 5 \text{ МГц}$, не более:

1T311A	50 пс
1T311B, ГТ311Ж, ГТ311И	100 пс
1T311G, 1T311D, 1T311K, 1T311L, ГТ311Е	75 пс

типовье значения:

1T311A	36* пс
1T311B	42* пс
1T311G	46* пс
1T311D, 1T311K, 1T311L	58* пс

Коэффициент шума при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 60$ МГц, $R_T = 75$ Ом, не более	8 дБ
типовыe значения:	
1T311A	4,7* дБ
1T311B	5,1* дБ
1T311Г, 1T311Л	5,2* дБ
1T311Д	5,9* дБ
1T311К	5,5* дБ
Время рассасывания при $I_k = 20$ мА для	
1T311A, 1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л, не более	50 нс
Границное напряжение при $I_3 = 10$ мА:	
$T = +25$ °C, не менее:	
1T311A	10 В
1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л	8 В
типовыe значения:	
1T311A	12,8* В
1T311B	12,6* В
1T311Г, 1T311K	12,2* В
1T311Д, 1T311Л	11,7* В
$T = +70$ °C для 1T311A, 1T311B, 1T311Г 1T311Д, 1T311K, 1T311Л, не менее	
5 В	
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 15$ мА, $I_b = 1,5$ мА, не более	
0,3 В	
типовое значение для 1T311A, 1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л	
0,15* В	
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 15$ мА, $I_b = 1,5$ мА, не более	
0,6 В	
типовое значение для 1T311A, 1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л	
0,43* В	
Обратный ток коллектора, не более:	
при $T = +25$ °C, $U_{KB} = 12$ В для 1T311A, 1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л	
5 мкА	
при $T = +25$ °C, $U_{KB} = 12$ В для ГТ311Е, ГТ311Ж	
10 мкА	
при $T = +25$ °C, $U_{KB} = 10$ В для ГТ311И	
10 мкА	
при $T = +55$ °C, $U_{KB} = 7$ В для ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И	
60 мкА	
при $T = +70$ °C, $U_{KB} = 7$ В для 1T311A, 1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л	
30 мкА	
Обратный ток эмиттера, не более:	
при $U_{EB} = 2$ В для 1T311A, 1T311B, 1T311Г, 1T311Д, 1T311K, 1T311Л	
10 мкА	

при $U_{\text{ЭБ}} = 2$ В для ГТ311Е, ГТ311Ж 15 мА
при $U_{\text{ЭБ}} = 1,5$ В для ГТ311И 15 мА

Емкость коллекторного перехода

при $U_{\text{КБ}} = 5$ В, не более 2,5 пФ
типовые значения:

1T311A, 1T311K, 1T311L 1,8* пФ
1T311B, 1T311G, 1T311D 1,5* пФ

Емкость эмиттерного перехода при

$U_{\text{ЭБ}} = 0,25$ В для 1T311A, 1T311B, 1T311G

1T311D, 1T311K, 1T311L, не более 5 пФ

типовые значения:

1T311A 4,1* пФ
1T311B 4,2* пФ
1T311G 3,9* пФ
1T311D, 1T311K, 1T311L 4,0* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

при $T = +45$ °С:

1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D,
1T311K, 1T311L, ГТ311Е, ГТ311Ж 12 В
ГТ311И 10 В

при $T = +55$ °С:

ГТ311Е, ГТ311Ж 10 В
ГТ311И 8 В

при $T = +70$ °С:

1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D,
1T311K, 1T311L 7 В

Импульсное напряжение коллектор—база

при $t_i = 1$ мкс, $Q = 10$:

$T = +20$ °С:

1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D,
1T311K, 1T311L 25 В
ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И 20 В

$T = +55$ °С для ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И .. 13 В

$T = +70$ °С для 1T311A, 1T311B, 1T311G,

1T311D, 1T311K, 1T311L 15 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{\text{Б}}/R_{\text{Э}} < 10$:

$T = +45$ °С для 1T311A, 1T311B,

1T311G, 1T311D, 1T311K, 1T311L,

ГТ311Е, ГТ311Ж 12 В

$T = +45$ °С для ГТ311И 10 В

$T = +55$ °С:

ГТ311Е, ГТ311Ж 10 В
 ГТ311И 8 В

$T = +70^{\circ}\text{C}$ для 1T311A, 1T311B, 1T311G,
 1T311D, 1T311K, 1T311L 7 В

Постоянное напряжение эмиттер—база:

при $T = +45^{\circ}\text{C}$:

1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D,
 1T311K, 1T311L, ГТ311Е, ГТ311Ж 2 В
 ГТ311И 1,5 В

при $T = +55^{\circ}\text{C}$:

ГТ311Е, ГТ311Ж 1,6 В
 ГТ311И 1,1 В

при $T = +70^{\circ}\text{C}$ для 1T311A, 1T311B,
 1T311G, 1T311D, 1T311K, 1T311L 1 В

Постоянный ток коллектора 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллекто-
ра:

при $T = +20^{\circ}\text{C}$ 150 мВт
 при $T = +55^{\circ}\text{C}$ для ГТ311Е, ГТ311Ж,
 ГТ311И 85,7 мВт

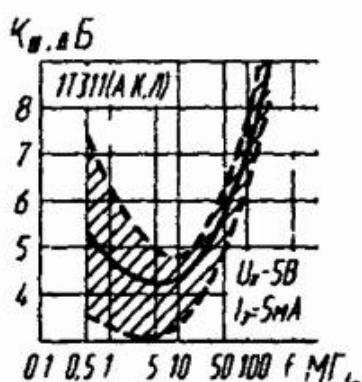
при $T = +70^{\circ}\text{C}$ для 1T311A, 1T311B,
 1T311G, 1T311D, 1T311K, 1T311L 50 мВ

Температура $p-n$ перехода:

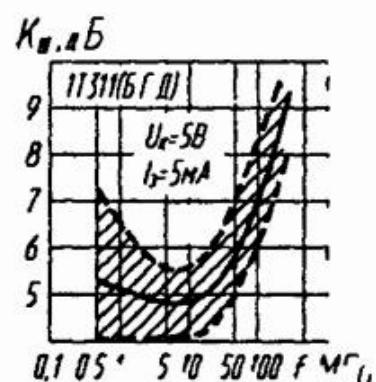
1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D, 1T311K,
 1T311L +85 °C
 ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И +70 °C

Температура окружающей среды:

1T311A, 1T311B, 1T311G, 1T311D, 1T311K,
 1T311L -60...+70 °C
 ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И -40...+55 °C



Зона возможных положений
зависимости коэффициента
шума от частоты



Зона возможных положений
зависимости коэффициента
шума от частоты